

2018年 第79回 応用物理学会秋季学術講演会 特別シンポジウム

GaNのエピタキシャル成長とデバイス科学

日時：平成30年9月20日 13:30-17:45

場所：名古屋国際会議場 センチュリーホール（CE会場）

入場無料

近年GaNはパワーデバイス材料として注目を集めています。本シンポジウムでは、GaNをパワーデバイス材料として作製するための最も基本となるエピタキシャル成長技術とGaNをパワーデバイスとして用いるための基礎となるデバイス科学に焦点を絞って、その最先端の研究をされている研究者の方々に最近の進展を話していただきます。

プログラム

- ① 13:30-13:45 はじめに 白石賢二（名大）
- ② 13:45-14:15 GaNデバイスのキラーとなる転位欠陥とその低減法
田中敦之、天野浩（名大）
- ③ 14:15-14:45 素子作製におけるGaNのエピタキシャル成長の可能性
松岡隆志、窪谷茂幸、谷川智之（東北大）
- ④ 14:45-15:15 計算科学で見るGaN エピタキシャル成長 伊藤智徳（三重大）
- ⑤ 15:15-15:45 GaNへのMg添加技術の最近の発展 成田哲生（豊田中研）
- ⑥ 15:45-16:15 GaN系絶縁膜制御技術 小出康夫（物質材料研究機構）
- ⑦ 16:15-16:45 イオン注入を用いたGaN系MOSFETの研究 高島信也（富士電機）
- ⑧ 16:45-17:15 GaN系パワーデバイス用ゲート絶縁膜技術 渡部平司（大阪大）
- ⑨ 17:15-17:45 GaN系パワーデバイスの最近の展開 須田淳（名大）

